

## Flip Chip Bonder



## 技術規格

Dry Tact	2 sec/Die
Accuracy	± 2 μm
Bond force	10 N – 350 N
Die size	5 – 35mm(L) , 0.5 – 3 mm (W)
Die thickness	0.2 – 1 mm
Wafer size	8" - 12" (on 8" or 12" wafer frames)
Film Width	Width : 35 , 48 , 70 mm
Bonding Process	Eutectic bonding
Temperature Range	≤ RT480°C
Size	2814(L) x 1439(W) x 1997(H) mm
Weight	3000 Kg

## 設備特性與優點

覆晶技術(Flip Chip)是將IC的金凸塊(Bump)與軟性線路板(Film)直接連結。捲帶封裝技術(COF)是透過熱壓將晶片上的金凸塊與軟性電路板上的內引腳接合的技術(Inner Lead Bonding , ILB)。

Flip Chip Bonder結合覆晶技術與捲帶封裝技術，利用共晶製程(Eutectic)達到高強度的IC鍵合。

- 高精度、高製程穩定度的COF封裝，貼合精度 $\pm 2\mu\text{m}$ 。
- 運用覆晶技術縮小IC封裝後的尺寸。
- 運用共晶製程(Eutectic)達到高強度的IC鍵合。
- COF專用Reel-to-reel (RTR) 收送料裝置。